

Тематический указатель статей, опубликованных в 2006 году

Фундаментальные исследования

Горбачев А.А., Широков А.Е. Метод эффективной массы и поверхностные состояния. № 5, с. 7.

Материалы электронной техники

Максимов С.К. Упорядоченная фаза La_2CaF_8 с модифицированной структурой тисонита. № 4, с. 3.

Технология микроэлектроники

Апрелов С.А., Герасименко Н.Н., Рыбачек Е.Н., Сенков В.М., Пиршин И.В., Турьянский А.Г., Цехош В.И. Двухволновая рентгеновская рефлектометрия пленок металлов и их силицидов на кремнии. № 5, с. 27.

Аскинази А.Ю., Барабан А.П., Милоглядова Л.В., Сазонов С.Г., Сергиенко М.В. Влияние ионной имплантации и УФ-облучения на зарядовое состояние структуры Si–SiO₂. № 3, с. 7.

Барабан А.П., Петров Ю.В., Сазонов С.Г. Электролюминесценция структур Si–SiO₂, содержащих избыточный кремний. № 2, с. 3.

Батюня Л.П. Технологические аспекты получения тонкопленочных структур для высокотемпературных сверхпроводников. № 1, с. 9.

Грибов Б.Г., Лысак Л.В., Мартемьянов В.С. Новый метод очистки кремниевых пластин. № 5, с. 15.

Гуцин О.П., Данилкин Е.В., Мочалов А.И. Травление кремния методом переменной модуляции газов SF₆ и C₄F₈. № 4, с. 8.

Зайцев Н.А., Матюшкин И.В. Исследование кинетики начального этапа высокотемпературного окисления кремния в сухом кислороде. № 2, с. 9.

Каракеян В.И., Рябышенков А.С. Обеспечение равномерности воздушного потока в чистом помещении высокотехнологичного производства. № 1, с. 13.

Ковалев А.А. Особенности технологического процесса очистки полупроводниковых структур на основе электрохимического синтеза и рекуперации растворов. № 4, с. 13.

Королёв М.А., Крупкина Т.Ю., Логинов В.В. Учет пространственной неоднородности распределения ловушек при моделировании КНИ МОП-структур. № 3, с. 3.

Манжа Н.М., Сауров А.Н. Влияние температуры осаждения на структуру слоев поликристаллического кремния. № 3, с. 14.

Рембеза Е.С., Рембеза С.И., Свистова Т.В., Дырда Н.Н. Методы повышения газочувствительных свойств пленок SnO₂ для датчиков газов. № 1, с. 3.

Скворцов А.М., Халецкий Р.А., Соколов В.И. Исследование характеристик структуры Si–SiO₂ с поликремниевым затвором в зависимости от режимов термического окисления. № 6, с. 3.

Тимошенко В.П. Расчет индуктивности корпуса для СВЧ интегральных микросхем. № 4, с. 18.

Тимошенко В.П. Состояние и перспективы развития технологии кремниевых гетеропереходных биполярных транзисторов для СВЧ применений. № 5, с. 19.

Тимошенко С.П., Зотов С.А., Калугин В.В., Воротников А.А., Рубчиц В.Г., Прокопьев Е.П. Влияние пористости поверхностных слоев на жесткость подвеса чувствительного элемента МЭМС на основе структур КНИ. № 6, с. 9.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы *

- Алексеев Ю.И., Малиёв И.В., Нащанский С.А.* Исследование влияния лазерного излучения на частоту колебаний ганновского генератора. № 2, с. 34.
- Безрядин Н.Н., Ассессоров В.В., Сизов С.В., Михайлюк Е.А., Сыноров Ю.В., Кузьменко Т.А., Пахомов В.Н.* Влияние металла на поверхностные электронные состояния кремния в слоистой системе $Me-Ga_2Se_3-(SiO_x)Si$. № 2, с. 18.
- Белин А.М., Никифоров А.Ю., Гваськов А.А., Попов А.Д., Рудаков Г.А.* Мультиплексор для охлаждаемого гибридного многоэлементного приемника ИК-излучения. № 1, с. 18.
- Бирюков В.Н.* Модель барьерной емкости диода с короткой базой. № 4, с. 31.
- Григорашвили Ю.Е., Карпов Р.Г., Степанов А.М.* Метод локации источников слабых магнитных полей. № 2, с. 37.
- Ионычев В.К., Ребров А.Н.* Численный расчет вероятности включения микроплазмы в $p-n$ -переходе. № 4, с. 23.
- Козлов А.В., Парменов Ю.А.* Влияние скорости поверхностной рекомбинации на относительную чувствительность биполярного магнитотранзистора. № 3, с. 27.
- Коноплев Б.Г., Рындин Е.А.* Интегральные логические элементы на основе туннельно-связанных наноструктур. № 3, с. 18.
- Кострюков С.А., Холомина Т.А.* Программное обеспечение НЧ шумовой спектроскопии глубоких уровней. № 4, с. 36.
- Лугин А.Н.* Учет тензочувствительности для толстопленочных резисторов на основе соединений рутения. № 1, с. 25.
- Строгонов А.В., Горлов М.И.* Использование нейронных сетей в задачах прогнозирования деградации выходных параметров ИС. № 4, с. 44.
- Широков А.А., Сергеев В.А., Дулов О.А.* Исследование токораспределения в биполярных транзисторах электрофлуктуационным методом. № 2, с. 26.
- Яремчук А.Ф., Мазуров А.В., Соколов Е.М., Шерченков А.А.* Метод оценки электрических параметров солнечных элементов в процессе контроля их эксплуатационных характеристик. № 4, с. 53.

Микроэлектронные приборы и системы

- Иванова О.М., Крутоверцев С.А., Анисимов В.А., Борисов А.Г., Чиликина Т.Д.* Оптический сенсор для определения аммиака в воздухе. № 6, с. 20.
- Бобрешиов А.М., Дыбой А.В., Китаев Ю.И., Нестеренко Ю.Н., Усков Г.К., Обрезан О.И.* Исследование обратимых отказов GaAs ПТШ при импульсных перегрузках. № 5, с. 69.
- Гваськов А.А., Жигальский Г.П., Ситкин П.О.* Исследование $1/f$ -шума МДП-транзисторов с разным типом проводимости канала. № 6, с. 13.
- Горлов М.И., Смирнов Д.Ю., Ануфриев Д.Л.* Классификация надежности интегральных схем с использованием показателя формы спектра γ . № 5, с. 78.
- Зайцев Д.Л., Дудкин П.В., Агафонов В.М.* Вихревые флуктуирующие потоки и их вклад в шумы молекулярно-электронных преобразователей. № 5, с. 61.
- Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Кострицкий С.М., Алкаев А.Н., Прилуцкий В.Е., Пономарев В.Г., Морев И.В., Марчук В.Г., Падерин Е.М.* Интерферометрические волоконно-оптические гироскопы с замкнутым контуром обратной связи. № 5, с. 45.
- Орликовский А.А.* Кремниевая транзисторная наноэлектроника. № 5, с. 35.

*С № 5, 2006 заменена на рубрику «Микроэлектронные приборы и системы».

Нанотехнология

Белов А.Н., Гаврилов С.А. Синтез полупроводниковых нитевидных нанокристаллов методом импульсного электрохимического осаждения с дальнейшей сульфидизацией. № 1, с. 31.

Белов А.Н., Гаврилов С.А., Путря М.Г., Шевяков В.И. Нанотехнологии на основе анодных оксидных материалов. № 5, с. 93.

Максимов С.К. Механизм наноструктурирования нестехиометрических фторидов $Ba_{1-x}La_xF_{2+x}$ и $Ca_{1-x}La_xF_{2+x}$ с решеткой на основе CaF_2 . № 5, с. 83.

Чаплыгин Ю.А., Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С. Методика измерения электропроводности нанометровых металлических пленок в слоистых структурах по спектрам отражения электромагнитного излучения. № 6, с. 27.

Схемотехника и проектирование

Артемов С.А. Конвертор для перевода проектов схем из САПР ПЛИС в САПР БМК. № 2, с. 57.

Кобзев Ю.М., Эннс В.В., Эннс В.И. Моделирование интегральных магниточувствительных схем на основе магниторезистивных элементов. № 6, с. 56.

Малинаукас К.К. Обзор алгоритмов поиска кратчайших путей в задачах сжатия топологии ИС. № 6, с. 36.

Соколов А.Г., Чепурных Е.А. Комплекс программ для автоматизированного проектирования интерфейсов цифрового оборудования. № 2, с. 52.

Стемковский А.Л., Гаврилов С.В., Глебов А.Л. Статистический подход к временному анализу цифровых схем. № 5, с. 99.

Петросяниц К.О., Торговников Р.А. Сравнительный анализ схемотехнических моделей SiGe гетеропереходного биполярного транзистора. № 5, с. 107.

Микросистемы

Комиссаров А.В., Степанов Н.В. Методы расширения диапазона измерений угловых скоростей микромеханических гироскопов ADXRS150, ADXRS300. № 2, с. 77.

Фёдоров Р.А., Шелепин Н.А. PSPICE-модель электретного преобразователя физических величин. № 4, с. 59.

Микропроцессорная техника

Беляев А.А., Путря Ф.М. Выбор оптимальной структуры функционально полного контроллера шины SPI с 32-разрядным интерфейсом. № 4, с. 71.

Ельчин И.С., Шагурин И.И., Осипенко П.Н., Василегин Б.В. Аппаратные средства введения помехоустойчивого кодирования для повышения отказоустойчивости СБИС оперативной памяти. № 4, с. 65.

Капустян С.Г. Децентрализованный метод коллективного распределения целей в группе роботов. № 2, с. 84.

Переверзев А.Л. Обнаружение импульсного сигнала с применением медианной фильтрации. № 1, с. 36.

Романов С.П. Повышение помехоустойчивости контроллера магистрального параллельного интерфейса. № 3, с. 32.

Сиренко В.Г. Метод локализации «враждебных» неисправностей в многомашинных вычислительных системах. № 3, с. 38.

Информационные технологии

- Абрамов А.Ю., Портнов Е.М.* Способ организации канала «прямых» измерений параметров распределительных электросетей. № 3, с. 50.
- Ашарина И.В.* Методы информационного согласования в двухкомплексной системе. № 6, с. 6.
- Беневоленский С.Б., Жадан В.Г., Жадан И.В., Спыну С.К.* Применение технологии распределенных вычислений при решении задач методом половинных делений для глобальной оптимизации функции многих переменных. № 3, с. 44.
- Власов А.А., Скулкин Н.М., Зуев А.В.* Использование экспертной системы для распознавания дефектов металлокерамических корпусов и коммутационных плат. № 2, с. 47.
- Гагарина Л.Г., Слюсарь В.В.* Методология оценки эффективности работы автоматизированной информационно-поисковой системы на основе интегральных критериев уровня качества поиска. № 2, с. 42.
- Джиган В.И.* Использование обратного QR-разложения в многоканальных FAP-алгоритмах. № 1, с. 60.
- Корнилов А.И., Калашиников В.С., Ласточкин О.В., Семенов М.Ю.* Особенности построения умножителей по модулю $(2^n - 1)$. № 1, с. 55.
- Янчук Е.Е.* Интегрированные устройства цифрового сопряжения мультиплексирования и каналообразования для радиорелейных линий связи. № 6, с. 65.

Интегральные радиоэлектронные устройства

- Джиган В.И.* Адаптивные фильтры на основе последовательных лестничных RLS-алгоритмов с априори ошибками. № 3, с. 61.
- Зиновьев Д.В.* Система ФАПЧ на цифровых логических элементах. № 2, с. 71.
- Клюев Д.С., Неганов В.А.* Расчет входного сопротивления узкой полосковой кольцевой антенны на основе сингулярного интегрального уравнения с ядром Гильберта. № 4, с. 76.
- Комаров В.В.* Аналитическая аппроксимация дисперсии электромагнитных волн в волноводах с поперечно-неоднородным диэлектрическим заполнением. № 3, с. 76.
- Меркутов А.С.* Маршрут автоматизированного проектирования радиоприемных устройств цифровых сигналов. № 3, с. 70.
- Маркосян Е.С.* Исследование характеристик несимметричных пассивных полифазных фильтров. № 1, с. 47.
- Чистюхин В.В.* Излучающая апертура АФАР Ку-диапазона для приема спутникового телевидения. № 1, с. 41.
- Чистюхин В.В., Лялин К.С., Сизов В.И., Кочетков В.Ю.* Пространственное подавление помех с использованием цифровой антенной решетки. № 2, с. 64.
- Чистюхин В.В., Сизов В.И., Лялин К.С., Викторов Ю.С., Семенов А.В.* Мобильная АФАР для приема сигнала спутникового телевидения. № 3, с. 54.

Методы и техника измерений

- Автунич О.А., Красин А.А.* Способ оценки неидентичности конденсаторов в блоке подстройки частоты кварцевого генератора. № 1, с. 68.
- Бельский М.Д., Суворинов А.В., Филипчук Т.С., Шахбазов С.Ю.* Расчет технологических допусков в электростатических линзах для электронно-лучевых микроколонн. № 1, с. 76.
- Горлов М.И., Смирнов Д.Ю., Ануфриев Д.Л.* Разделение интегральных схем по надежности с использованием $1/f$ -шума. № 1, с. 84.
- Дёмкин В.И., Макаров Е.С., Никулин В.Б.* Структура координатной системы движущихся объектов. № 3, с. 82.
- Филиппов В.В., Поляков Н.Н., Мицук С.В.* Восемизондовый метод совместных измерений электропроводимости и коэффициента Холла анизотропных полупроводниковых пленок. № 4, с. 81.

Проблемы высшего образования

Усанов Д.А. Школа А.Ф.Иоффе как пример единства науки, образования и производства. № 5, с. 118.

Чаплыгин Ю.А., Поспелов А.С., Гаврилов С.А., Прокофьев А.А. Центры формирования компетенций как механизм реализации компетентностного подхода в подготовке и переподготовке инженерных кадров для инновационной экономики. № 6, с. 79.

Краткие сообщения

Алексейчук А.В., Батюня Л.П., Раскин А.А. Особенности технологии изготовления кантилеверов. № 1, с. 92.

Аникин А.В., Литвинов Ю.М. Рентгеновская диагностика структуры и глубины повреждений в механически обработанных пластинах сапфира. № 6, с. 89.

Вернер В.Д. О терминологии микросистемной техники (в порядке дискуссии). № 3, с. 87.

Зотов С.А. Метод контроля номинальных значений емкостей МЭМС. № 4, с. 90.

Калугин В.В. Подготовка и сборка микромеханических элементов с емкостной системой съема перемещений. № 4, с. 92.

Малкова А.С., Пашинкин А.С., Надыров Ш.М. Теплоемкость антимолибдатов алюминия, галлия, индия. № 2, с. 94.

Названов В.Ф., Сусяков Ю.В. Об одной особенности спектральной характеристики гетероструктуры ZnS–GaP. № 3, с. 85.

Неустроев А.С., Неустроев С.А. Сопоставление рентгеновского и пикнометрического методов оценки качества слоев нитрида алюминия. № 2, с. 92.

Никулин В.Б., Иноземцев Н.В. Сравнение статистического и интервального методов при решении задач градуировки средств измерения. № 1, с. 90.

Новиков С.Г., Гурин Н.Т., Корнеев И.В. Моделирование фотоприемника с отрицательной проводимостью на основе полупроводниковой структуры. № 4, с. 88.

Умняшкин С.В., Коплович Д.М., Черкасов И.В., Александров А.А. Алгоритм сжатия изображений на основе контекстного скалярно-векторного квантования в области дискретного вейвлет-преобразования. № 6, с. 86.

Шорин Д.В. Методика разработки многофункциональной операционной системы для смарт-карты. № 2, с. 96.

Юбилеи

Вернер В.Д. Журналу «Известия высших учебных заведений. Электроника» – 10 лет. № 5, с. 3.

Кубареву Юрию Васильевичу – 70 лет. № 5, с. 126.

Коледову Леониду Александровичу – 70 лет. № 2, с. 97.

Мурыгину Виктору Ивановичу – 80 лет. № 1, с. 94.

Неустроеву Степану Архиповичу – 80 лет. № 5, с. 124.

Носову Юрию Романовичу – 75 лет. № 5, с. 125.

Таирову Юрию Михайловичу – 75 лет. № 6, с. 91.

Конференции. Семинары. Выставки

14 Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2007». № 6, 3 стр. обложки.

V Международная научно-техническая конференция «Электроника и информатика – 2005» (23–25 ноября 2005 г.). № 1, с. 96.

Международная школа-конференция по приоритетным направлениям науки и техники с участием молодых ученых, аспирантов и студентов стран-членов СНГ «Информационно-телекоммуникационные системы» (23–24 ноября 2005 г.). № 1, с. 97.

I Межотраслевое совещание по подготовке и переподготовке специалистов в области проектирования современной электронной компонентной базы и микроэлектронных систем (22 ноября 2005 г.). № 1, с. 98.

Всероссийская конференция инновационных проектов аспирантов и студентов по приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы» (16–17 ноября 2005 г.). № 1, с. 99.

Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании» (27 сентября 2005 г., Республика Абхазия, Пицунда). № 1, с. 100.

Десятая международная научная конференция и молодежная школа-семинар «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники» ПЭМ–2006. № 2, с. 25.

Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». № 2, с. 76.

Вернер В.Д., Ильков А.В. Инновации для инноваций (выставка «Продуктроника – 2005». г. Мюнхен, Германия). № 3, с. 89.

Об итогах 13-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2006». № 3, с. 93.

Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». № 3, с. 49.

Десятая международная научная конференция и молодежная школа-семинар «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники» ПЭМ–2006. № 3, с. 75.

Телемост «Кремль – регионы». № 4, с. 94.

Всероссийский конкурс инновационных проектов аспирантов и студентов «Индустрия наносистем и материалы». № 5, 2 стр. обложки.

Открытие совместной образовательной программы МИЭТ и компании Synopsys. № 5, 2 стр. обложки.

I специализированная выставка научных работ студенческой лаборатории «Фотоника II – VI». № 5, с. 82.